Produktkatalog

Passive HF-Netzwerke und Impedanzkomponenten

Technische Auswahl passiver HF-Lasten, Abschlüsse, Anpass- und Entzerrnetzwerke sowie impedanzbestimmender Bauteile nach Frequenz, Bezugsebene, Reflexion, Leistung, Temperatur und Einsatzumgebung.



Produkte: 11

Revision: 7 · Revisionsdatum: 2026-11-11

HF-Widerstände



LCRES-R15OHM

15 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 15 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.35 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.8 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

Anzahl der Widerstände: Wert: 1

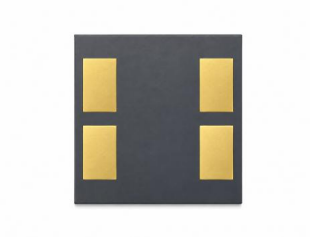
Anzahl der Anschlüsse: Wert: 2

Widerstand: Typisch: 15; Einheit: Ω

Widerstandstoleranz: Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 20 / 20 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.165 / 0.165 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.33 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

Anzahl der Widerstände: Wert: 2

Anzahl der Anschlüsse: Wert: 4

Widerstand: Typisch: 20 / 20; Einheit: Ω

Widerstandstoleranz: Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCRES-R50OHM

50 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 50 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.2 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.6 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

Anzahl der Widerstände: Wert: 1

Anzahl der Anschlüsse: Wert: 2

Widerstand: Typisch: 50; Einheit: Ω

Widerstandstoleranz: Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCRES-R1000OHM

1000 Ω GaAs-Dünnschichtwiderstandschip

Widerstand: 1000 Ω (typisch); Linearer Betriebsstrom: 0.04 A (typisch); Maximal zulässiger Strom: 0.08 A (Maximum). Chipabmessungen in der Draufsicht: 0.5 × 0.5 mm.

Anzahl der Widerstände: Wert: 1

Anzahl der Anschlüsse: Wert: 2

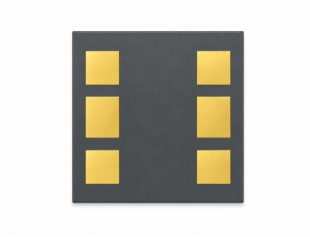
Widerstand: Typisch: 1000; Einheit: Ω

Widerstandstoleranz: Typisch: ±5; Einheit: %

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt

HF-Kondensatoren



LCCAP-C10PF

10 pF GaAs-Kondensatorchip

Kapazität: 10 pF (typisch); Spannungsfestigkeit: 50 V (typisch). Chipabmessungen: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

Kapazität: Typisch: 10; Einheit: pF; TA = +25 °C

Spannungsfestigkeit: Typisch: 50; Einheit: V; TA = +25 °C

Durchbruchspannung: Wert: 80 (Vb); Einheit: V

Lagertemperatur: Minimum: -65; Maximum: 150; Einheit: °C

Produktdetails Produktdatenblatt

HF-Entzerrer



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz GaAs-Flankenentzerrerchip

Entzerrungsbetrag: 2 dB; Einfügedämpfung @ 8000 MHz: 2.6 dB; Einfügedämpfung @ 12000 MHz: 0.7 dB. Chipabmessungen: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

Entzerrungsbetrag: Wert: 2; Einheit: dB

Einfügedämpfung @ 8000 MHz: Wert: 2.6; Einheit: dB

Einfügedämpfung @ 12000 MHz: Wert: 0.7; Einheit: dB

Produktdetails Produktdatenblatt



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz GaAs-Flankenentzerrerchip

Entzerrungsbetrag: 5.5 dB; Einfügedämpfung @ 2000 MHz: 0.6 dB; Einfügedämpfung @ 6000 MHz: 6.1 dB. Chipabmessungen: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

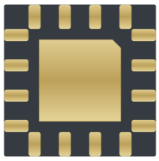
Betriebsfrequenz: Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

Entzerrungsbetrag: Wert: 5.5; Einheit: dB

Einfügedämpfung @ 2000 MHz: Wert: 0.6; Einheit: dB

Einfügedämpfung @ 6000 MHz: Wert: 6.1; Einheit: dB

Produktdetails Produktdatenblatt



LCEQ-8000-12000-C

8000–12000 MHz Gehäuster RF-Entzerrer — ΔIL 2 dB; IL -3.1 → -1.1 dB (typisch)

8000–12000 MHz; Entzerrhub 2 dB (typisch); Einfügedämpfung an der unteren Bandgrenze -3.1 dB (typisch) @ 8000 MHz; Einfügedämpfung an der oberen Bandgrenze -1.1 dB (typisch) @ 12000 MHz.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 8000; Maximum: 12000; Wert: 8000–12000; Einheit: MHz

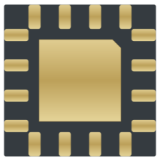
Einfügedämpfung an der unteren Bandgrenze: Typisch: -3.1; Wert: f = 8000 MHz; Einheit: dB

Einfügedämpfung an der oberen Bandgrenze: Typisch: -1.1; Wert: f = 12000 MHz; Einheit: dB

Entzerrhub: Typisch: 2; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCEQ-2000-6000-C

2000–6000 MHz Gehäuster RF-Entzerrer — ΔIL 5.5 dB; IL -1 → -6.5 dB (typisch)

2000–6000 MHz; Entzerrhub 5.5 dB (typisch); Einfügedämpfung an der unteren Bandgrenze -1 dB (typisch) @ 2000 MHz; Einfügedämpfung an der oberen Bandgrenze -6.5 dB (typisch) @ 6000 MHz.

Betriebsfrequenz: Symbol: f; Minimum: 2000; Maximum: 6000; Wert: 2000–6000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung an der unteren Bandgrenze: Typisch: -1; Wert: f = 2000 MHz; Einheit: dB

Einfügedämpfung an der oberen Bandgrenze: Typisch: -6.5; Wert: f = 6000 MHz; Einheit: dB

Entzerrhub: Typisch: 5.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz GaAs-RF-Kreuzungsbrückenchip

Einfügedämpfung: 0.4 dB (typisch); Isolation: 30 dB (typisch); Rückflussdämpfung: 20 dB (typisch). Chipabmessungen: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 40000; Wert: DC–40000; Einheit: MHz

Einfügedämpfung: Typisch: 0.4; Einheit: dB

Isolation: Typisch: 30; Einheit: dB

Rückflussdämpfung: Typisch: 20; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt

HF-Abschlusswiderstände und Dummy-Loads



LCLOAD-6000-25

RF-Abschlusslast für DC–6 GHz, 25 W

50-Ω-Abschlusslast für DC–6 GHz mit typisch 25 W und mindestens 20 W CW-Belastbarkeit. Das typische VSWR beträgt 1,3:1.

Betriebsfrequenz: Minimum: DC; Maximum: 6000; Einheit: MHz

CW-RF-Belastbarkeit: Minimum: 20; Typisch: 25; Einheit: W

VSWR: Typisch: 1.3:1

Impedanz: Typisch: 50; Einheit: Ω

25 °C; 50 Ω

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.